

研究評価委員会

「高集積・複合 MEMS 製造技術開発プロジェクト」(事後評価) 分科会

日 時：平成21年10月5日(月曜日) 10:15～18:00

場 所：WTCコンファレンスセンター 3階 RoomA

議事次第

<公開の部>

- | | | | |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認 | | 10:15～10:20(5分) | |
| 2. 分科会の公開について | | 10:20～10:25(5分) | |
| 3. 評価の実施方法 | | 10:25～10:30(5分) | |
| 4. 評価報告書の構成について | | 10:30～10:35(5分) | |
| 5. プロジェクトの概要説明 | | 10:35～11:45(説明40分、質疑30分) | |
| (1) 事業の位置付け・必要性 | } | NEDO 犬塚主査 10:35～10:55(20分) | |
| (2) 研究開発マネジメント | | | |
| (3) 研究開発成果 | | | 東大 下山教授 10:55～11:15(20分) |
| (4) 実用化の見通し | | | |
| (5) 質疑 | | 11:15～11:45(30分) | |
| (昼食・休憩 45分) | | 11:45～12:30(45分) | |

<非公開の部>

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 6. プロジェクトの詳細説明【助成】 | 12:30～16:05(説明112分、質疑80分) |
| ・分科会の非公開について | 12:30～12:35(5分) |

【入れ替え】

①MEMS／ナノ機能の複合技術の開発

①-1. ナノ機能を組み込んだMEMSデバイスの製造技術

三菱電機 12:35～13:00(入替1分、説明14分、質疑10分)

②MEMS／半導体の一体形成技術の開発

②-1. MEMS - 半導体プロセス統合モノリシック製造技術

日立 13:00～13:25(入替1分、説明14分、質疑10分)

②-2. MEMS - 半導体縦方向配線技術－1

オムロン 13:25～13:50(入替1分、説明14分、質疑10分)

②-3. MEMS - 半導体縦方向配線技術－2

フジクラ 13:50～14:15(入替1分、説明14分、質疑10分)

(休憩 10分)

14:15~14:25(10分)

②-4. MEMS－半導体横方向配線技術

東芝 14:25~14:50 (入替1分、説明14分、質疑10分)

③MEMS/MEMSの高集積結合技術の開発

③-1. 異種材料多層MEMS集積化技術

オリンパス 14:50~15:15 (入替1分、説明14分、質疑10分)

③-2. ビルドアップ型多層MEMS集積化技術－1

パナソニック電工 15:15~15:40 (入替1分、説明14分、質疑10分)

③-3. ビルドアップ型多層MEMS集積化技術－2

横河電機 15:40~16:05 (入替1分、説明14分、質疑10分)

(休憩 10分 ・ 一般傍聴者入室)

16:05~16:15(10分)

<公開の部>

7. プロジェクトの詳細説明【委託】 16:15~17:30 (説明112分、質疑80分)

・基礎的・基盤的研究開発

①MEMS/ナノ機能の複合技術の開発

②MEMS/半導体の一体形成技術の開発

③MEMS/MEMSの高集積結合技術の開発

} 立命館大 杉山教授

16:15~17:05 (説明30分、質疑20分)

・知的基盤・標準整備などの研究開発

④高集積・複合MEMS知識データベースの整備

マイクロマシンセンター 17:05~17:17 (説明7分、質疑5分)

⑤高集積・複合MEMSシステム化設計プラットフォームの開発

マイクロマシンセンター 17:17~17:30 (説明8分、質疑5分)

8. 全体を通しての質疑応答

17:30~17:40 (10分)

9. まとめ・講評

17:40~17:55 (15分)

10. 今後の予定、その他

17:55~18:00 (5分)

11. 閉会